

Vrijeme izvoza: 11.05.2025. 01:10:09

Repozitorij: repozitorij.pmf.unizg.hr

Ukupan broj zapisa na URL-u: 8

Broj izvezenih zapisa: 8

Naslov	URL	Autori	Naslov izvornika
Uloga bora kao neželjene primjese u n-tipu SiC		Jelavić, Eva	
Boron-Related Defects in N-Type 4H-SiC Schottky Barrier Diodes		Knezevic, Tihomir; Jelavić, Eva; Yamazaki, Yuichi; Ohshima, Takeshi; Makino, Takahiro; Capan, Ivana	
Razvoj konvertera za učinkovitu detekciju termalnih neutrona		Bernat, Robert	
Karakterizacija električki aktivnih defekata u 4H-SiC metodama tranzijentne spektroskopije		Brodar, Tomislav	
Kapacitivna tranzijentna spektroskopija za proučavanje defekata uvedenih ionskom implantacijom		Bakrač, Luka	
Tranzijentna spektroskopija manjinskih nosioca		Markota, Gabrijela	
Električki aktivni defekti u 4H-SiC uvedeni zračenjem		Brodar, Tomislav	
Transportna svojstva poluvodičkih detektora		Blažeka, Damjan	